

XJIPC OpenIR > 固体辐射物理研究室

基于p-i-n结构的位移损伤剂量探测方法

于新; 杨发斌; 张华雷; 郭雷; 文柱; 张兴亮; 孙静; 李福东

2017-09-01

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型 发明专利

摘要 本发明涉及一种基于p-i-n结构的位移损伤剂量探测方法,该方法包括制备p-i-n结构的探测,探测参数调整及确认,在不需对探测下表面进行刻蚀的情况下,根据不同剂量率的待测材料对地堆高剂量率EL,再经探测电路完成对探测信号采集,通过探测电路输出探测信号,该方法适用于对探测信号采集是位移损伤剂量,包括在可探测位移损伤剂量的范围内,与探测剂子的种类、能量相比,能够直接反映中子元件器件的位移损伤程度,基于此探测方法可探测类型、范围、应用,适用于空环环境监测、半导体元件中子位移损伤效应评价及寿命预测。

申请日期 2014-11-10

专利状态 已授权

申请号 CN201410429535.5

公开(公告)号 CN104459372B

代理机构 乌鲁木齐中科新兴专利事务所 65105

文献类型 **专利**

条目标识符 <http://ir.hanhanzhu.cn/handle/365002/6791>

专题 固体辐射物理研究室

推荐引用格式 于新;杨发斌;张华雷等. 基于p-i-n结构的位移损伤剂量探测方法. CN104459372B[P]. 2017-09-01. GB/T 7714

系统包含的文件
各语言相关文件

所有评论 (0)
暂无评论

个性服务

- 推荐项目
- 推荐收藏
- 定制计划
- 导出为EndNote文件
- 检索学术
- 必应学术中相似的文章
- 于新的文章
- 杨发斌的文章
- 张华雷的文章
- 郭雷的文章
- 文柱的文章
- 张兴亮的文章
- 孙静的文章
- 李福东的文章
- 张华雷的文章
- 郭雷的文章
- 文柱的文章
- 张兴亮的文章
- 孙静的文章
- 李福东的文章
- 张华雷的文章
- 郭雷的文章
- 文柱的文章
- 张兴亮的文章
- 孙静的文章
- 李福东的文章

收藏/分享
复制链接
新浪微博
腾讯微博
QQ空间
豆瓣
人人网
百度云